



G2022 250V 1.2A 单相高低侧功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片

1 产品特性

- 自举工作的浮地通道
 - 最高工作电压为+250 V
 - 兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑
 - dV_s/dt 耐受能力可达 ± 50 V/ns
 - V_s 负偏压能力达 -9V
 - 栅极驱动电压从 5 V 到 20V
 - 集成欠压锁定电路
 - 欠压锁定正向阈值 4.4V
 - 欠压锁定负向阈值 4.2V
 - 防直通死区逻辑
 - 死区时间设定 200ns
 - 芯片传输延时特性
 - 开通/关断传输延时 $T_{on}/T_{off} = 150ns/140ns$
 - 延迟匹配时间 50ns
 - 宽温度范围 $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
 - 输出级拉电流/灌电流能力 1.2A/1.5A
 - 符合 RoSH 标准
- SOIC8 (S)

2 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 微型逆变器驱动

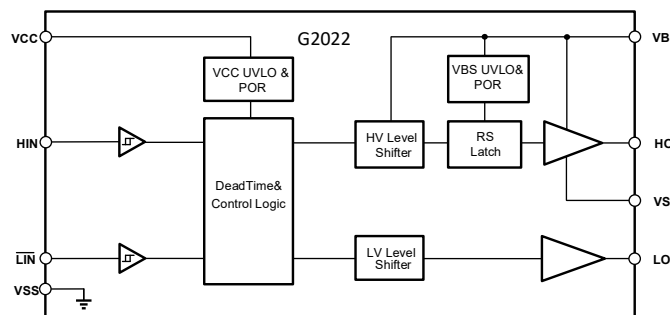
3 产品概述

G2022 是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。G2022 采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成，逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出具有大电流脉冲能力和防直通的死区逻辑。G2022 其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET，浮地通道最高工作电压可达 250V。G2022 采用 SOIC8 封装，可以在 $-40^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$ 温度范围内工作。

器件信息

| 零件号 | 封装 | 封装尺寸 (标称值) |
|-------|-------|-------------|
| G2022 | SOIC8 | 4.9mm*3.9mm |

简化示意图



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>NSIC](#)